

課題番号 : F-20-HK-0055  
利用形態 : 技術相談  
利用課題名(日本語) : 半導体用薄膜の原子層堆積法  
Program Title (English) : Thin Film Deposition for Semiconductor Devices by Atomic Layer Deposition  
利用者名(日本語) : 西田章浩  
Username (English) : Akihiro Nishida  
所属名(日本語) : 株式会社 ADEKA 電子材料開発研究所 半導体材料研究室  
Affiliation (English) : Semiconductor Materials Department, Electronic Materials Development Laboratory, R & D Division, ADEKA Corporation  
キーワード/Keyword : 半導体、ALD、膜加工・エッチング、成膜・膜堆積

## 1. 概要(Summary)

近年、半導体デバイスは微細化に伴い原子レベルの均一性を有した膜厚 10nm 以下の薄膜を成膜することが求められている。そのような薄膜を成膜する手法として、原子層堆積法(Atomic Layer Deposition, ALD)が注目されている。当研究室では種々の ALD 材料を開発しており、その成膜特性の確認のため、北海道大学の ALD 装置を利用し薄膜作成を行うため検討を行った。

## 2. 実験(Experimental)

<技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。>

## 3. 結果と考察(Results and Discussion)

<技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。>

## 4. その他・特記事項(Others)

なし。

## 5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

## 6. 関連特許(Patent)

なし。